

ПРИМЕСЬ ИНДИЯ В СЕЛЕНИДЕ СВИНЦА — ЦЕНТР С ОТРИЦАТЕЛЬНОЙ КОРРЕЛЯЦИОННОЙ ЭНЕРГИЕЙ

Вейс А. Н., Прокофьева Л. В.

Исследованы спектральные зависимости коэффициента поглощения в $\text{PbSe}\langle\text{In}, \text{Cl}\rangle$ с энергиями Ферми (E_F), как меньшими, так и большими значений E_F в режиме пиннинга (E_F^*) при 300 К. Экспериментальные результаты сравниваются с данными для $\text{PbSe}\langle\text{Cl}\rangle$. Показано, что частотная зависимость коэффициента примесного поглощения изменяется в зависимости от величины E_F . При $E_F < E_F^*$ полосы примесного поглощения обладают резкой коротковолновой границей и связаны с оптическими переходами электронов из зоны проводимости в пустые примесные центры, расположенные выше E_F . При $E_F > E_F^*$ полосы примесного поглощения обладают резкой красной границей и связаны с оптической перезарядкой примесных центров $\text{In}^- \rightarrow \text{In}^0$. При возрастании холловской концентрации электронов красная граница примесного поглощения смещается в коротковолновую область спектра, свидетельствуя о том, что при $E_F > E_F^*$ примесный уровень расположен ниже E_F . Оценено энергетическое положение уровней, связанных с In^0 и In^- . Показано, что изменение зарядового состояния примеси при введении в $\text{PbSe}\langle\text{In}\rangle$ галогена сопровождается существенным понижением энергии примесного центра.

$\text{PbSe}\langle\text{In}\rangle$ исследован мало [1] по сравнению с $\text{PbTe}\langle\text{In}\rangle$. Особенности донорного действия индия в PbSe были изучены в [2], где показано, что в образцах с малыми концентрациями введенной примеси (N_{In}) каждый примесный атом создает один электрон в зоне проводимости, а при $N_{\text{In}} \geq 0.8$ ат % (ниже предела растворимости [1]) электронная концентрация стабилизируется на уровне $n_x \approx 1 \cdot 10^{20} \text{ см}^{-3}$ ($T = 77$ К). Эффект стабилизации n_x в $\text{PbSe}\langle\text{In}\rangle$ был истолкован в [2] в рамках модели квазилокального уровня E_0 . Впоследствии [3, 4] был выполнен новый цикл исследований $\text{PbSe}\langle\text{In}\rangle$. При этом в спектрах коэффициента поглощения $a(\hbar\omega)$ $\text{PbSe}\langle\text{In}\rangle$ в образцах с энергией Ферми E_F ниже уровня пиннинга E_F^* выявлены полосы примесного поглощения, связанные с оптическими переходами электронов из зоны проводимости в пустые примесные состояния. Это позволило [3] определить энергию оптической перезарядки примесного центра $\text{In}^+ \rightarrow \text{In}^0$ ($E_0^0 \rightarrow 1$, заряд указан относительно атомов подрешетки металла). При исследовании явлений переноса [4] наблюдались эффекты, связанные с резонансным рассеянием электронов в примесные состояния. Казалось бы, что новые эксперименты [3, 4] убедительно подтвердили модель квазилокального уровня E_0 . Однако авторами [4] было обнаружено необъяснимое в рамках модели квазилокального уровня E_0 уменьшение числа состояний в примесной полосе по мере заполнения их электронами в процессе дополнительного легирования $\text{PbSe}\langle\text{In}\rangle$ галогеном. Это кажущееся уменьшение плотности примесных состояний может быть следствием того, что заполнение примесных состояний электронами сопровождается существенным изменением энергии примесных центров. Цель настоящей работы — получение прямого экспериментального подтверждения указанной модели.

В качестве метода исследования избрано изучение спектральных зависимостей коэффициента поглощения при 300 К. Объектами исследований служат поликристаллические образцы $\text{PbSe}\langle\text{In}\rangle$, $\text{PbSe}\langle\text{Cl}\rangle$ и $\text{PbSe}\langle\text{In}, \text{Cl}\rangle$. В соответствии с [4] дополнительное введение в $\text{Pb}_{0.995}\text{In}_{0.005}\text{Se}$ хлора, не создающего в халькогенидах свинца квазилокальных состояний [1], в количествах $N_{\text{Cl}} \geq 2 \cdot 10^{20} \text{ см}^{-3}$ позволяет достигать в образцах высоких значений энергии Ферми,

существенно превосходящих E_F^* . Тем самым в оптических экспериментах оказывается возможным использовать образцы, в которых величины энергии Ферми как меньше, так и больше E_F^* . В связи с тем что в модели центра с отрицательной корреляционной энергией ($U < 0$) пиннинг E_F осуществляется за счет постепенного перехода индия из состояния In^+ в состояние In^- ^[5, 6], исследование спектров $\alpha(\hbar\omega)$ в $PbSe\langle In, Cl \rangle$ позволит изучить процесс оптической перезарядки примесных центров $In^- \rightarrow In^0$ при переводе одного примесного электрона в пустые состояния зоны проводимости.

Экспериментальные результаты, полученные в настоящей работе, показаны на рис. 1. Как видно из рис. 1 (зависимость 1), в спектре $\alpha(\hbar\omega)$ образца $PbSe\langle In, Cl \rangle$ с низкими концентрациями введенных примесей (и соответственно холловской концентрацией электронов n_x , определенной при 300 К), в котором примесные центры находятся в состоянии In^+ , наблюдаются полосы примесного поглощения α_0 с резкой коротковолновой границей E_{kb} , отмеченной на рис. 1 стрелкой. Форма спектральной зависимости $\alpha_0(\hbar\omega)$ и положение E_{kb} в шкале энергий соответствуют данным^[3] для $PbSe\langle In \rangle$, не содержащего хлора. При этом в соответствии со схемой на рис. 1, а из оптических данных может быть определена одноэлектронная энергия примесного уровня, соответствующая состоянию In^0 ($E_0^0 \rightarrow 1$). Расчет, проведенный по методике, изложенной в^[8] (рис. 2), показал, что в исследованном образце величина $E_0^0 \rightarrow 1$ составляет 0.29 ± 0.02 эВ ($T=300$ К), что согласуется с данными^[8]. Это свидетельствует о том, что введение хлора в $PbSe\langle In \rangle$ не влияет заметным образом на параметры примесных центров в состоянии In^0 .

В образцах с высокими n_x , в которых $E_F > E_F^*$, а примесные центры находятся в состоянии In^- , вид примесного спектра резко меняется. Как видно из рис. 1 (зависимости 3, 4), в спектрах $\alpha(\hbar\omega)$ появляются полосы примесного поглощения, обладающие резкой красной границей (на рис. 1 ее положение отмечено стрелками). Форма полос позволяет связать их с одноэлектронными переходами между примесным уровнем, расположенным ниже E_F , и пустыми состояниями зоны проводимости. Такие переходы соответствуют оптической перезарядке примесных центров $In^- \rightarrow In^0$. Поскольку необходимая для этого энергия $E_0^2 \rightarrow 1$ зависит от величины E_F , красная граница примесного поглощения «отслеживает» изменение E_F в образцах, смещаясь в коротковолновую область спектра при возрастании n_x , в соответствии со схемой на рис. 1, б.

Знак корреляционной энергии U в $PbSe\langle In \rangle$ может быть определен при сравнении энергий $E_0^2 \rightarrow 1$ и $E_0^* = E_F - E_0^2 \rightarrow 1$. Для определения E_0^* в образцах с различными n_x (а следовательно, и E_F) был выполнен расчет спектров примесного поглощения, связанного с перезарядкой примесных центров $In^- \rightarrow In^0$. Для этого спектральные зависимости $\alpha_0(\hbar\omega)$ были выделены из экспериментальных кривых $\alpha(\hbar\omega)$ $PbSe\langle In, Cl \rangle$ путем вычитания данных, полученных в $PbSe\langle Cl \rangle$ с близкими n_x (рис. 1, зависимости 5—7), и показаны на рис. 2. Расчет спектров примесного поглощения при $E_F > E_F^*$ произведен по формуле

$$\alpha \sim \frac{\sqrt{E} (1 + 2EE_g^{-1}) (1 + EE_g^{-1})^{1/2} [1 - f(E)]}{\hbar\omega (E_g + E_0^* + E)^2}, \quad (1)$$

полученной в предположениях, использованных в^[3] при построении зависимостей $\alpha_0(\hbar\omega)$, соответствующих оптической перезарядке примесных центров $In^- \rightarrow In^0$ в чистом $PbSe\langle In \rangle$, в котором $E_F < E_F^*$. В формуле (1) $E_0^* = E_F - E_0^2 \rightarrow 1$, $E = E_0^* + \hbar\omega$, E_g — ширина запрещенной зоны чистого $PbSe$, $f(E)$ — функция распределения Ферми. Определение величин E_F выполняли по формуле (6.27) работы^[7], исходя из измеренных n_x , с использованием зонных параметров чистого селенида свинца. О слабом влиянии индия на величины зонных параметров $PbSe$ свидетельствуют не только данные^[1—4], но и собственные результаты авторов по исследованию эффективных масс восприимчивости в $PbSe\langle In \rangle$, $PbSe\langle Cl \rangle$ и $PbSe\langle In, Cl \rangle$.

Результаты расчета $\alpha_0(\hbar\omega)$ в $PbSe\langle In, Cl \rangle$ показаны линиями на рис. 2. Хорошее согласие между расчетными и экспериментальными зависимостями $\alpha_0(\hbar\omega)$ позволило оценить величины E_0^* в различных образцах, оказавшиеся существенно меньшими $E_0^2 \rightarrow 1$ и равными $0.02 \div 0.12$ эВ. Отметим, что в модели

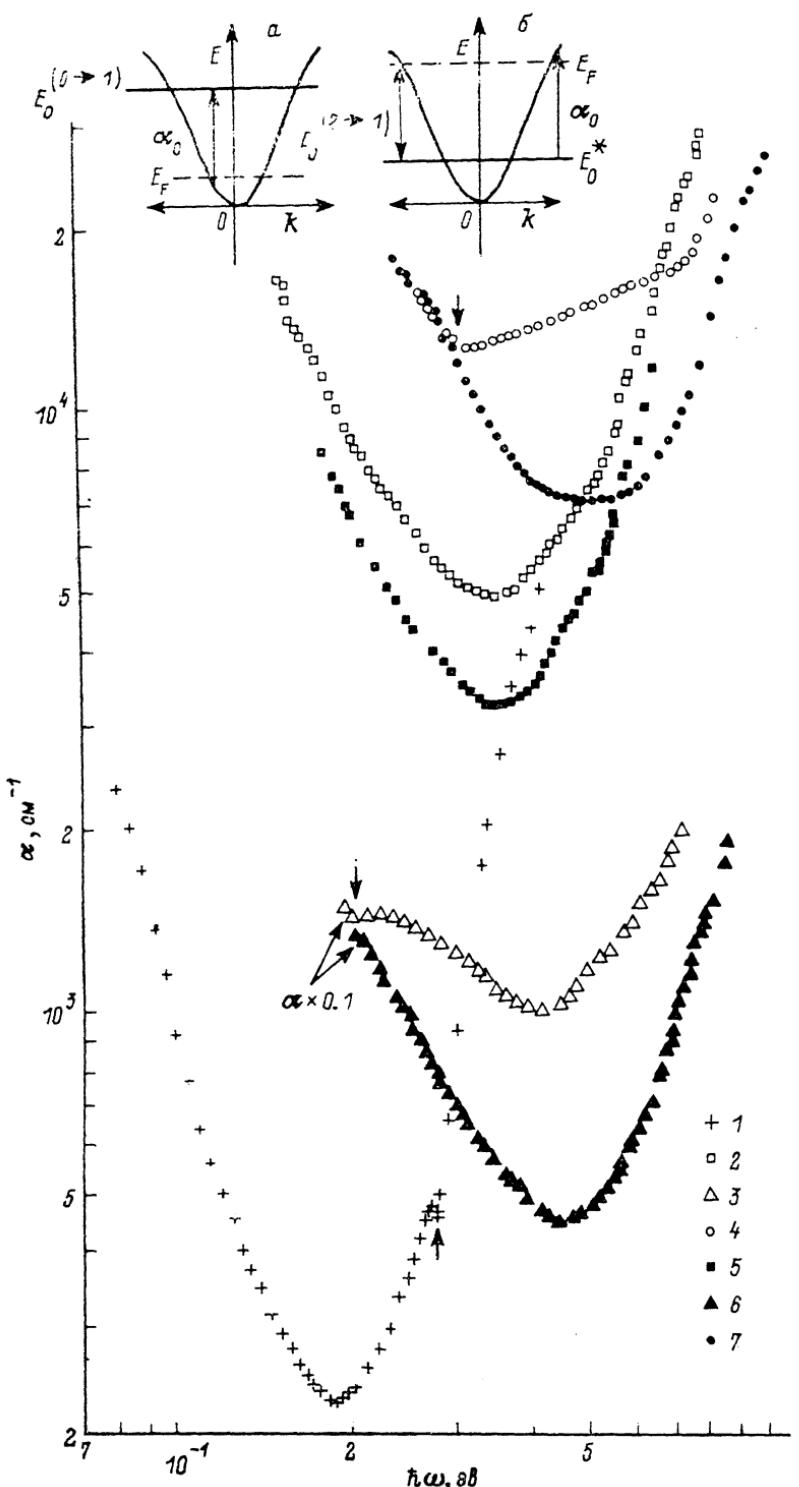


Рис. 1. Спектральные зависимости коэффициента поглощения в $\text{PbSe}\langle\text{In}, \text{Cl}\rangle$ (1-4) и $\text{PbSe}\langle\text{Cl}\rangle$ (5-7).

$T = 300 \text{ K}$; $n_x \cdot 10^{-19}$, cm^{-3} (N_{In} , ат.-%): 1 — 1.15 (0.03), 2 — 11.8 (0.5), 3 — 18.8 (0.5), 4 — 30.0 (0.5), 5 — 41.1 (0), 6 — 19.8 (0), 7 — 29.8 (0). На вставках — энергетическая схема $\text{PbSe}\langle\text{In}, \text{Cl}\rangle$ при $E_F < E_F^*$ (a) и $E_F > E_F^*$ (б).

квазилокального уровня E_0 [1, 2], в которой $E_0^* \approx E_0^0 \rightarrow 1$, в экспериментах, как это видно из рис. 2 (зависимость 5), не удалось бы наблюдать красной границы примесного поглощения даже в образцах с самыми высокими n_x .

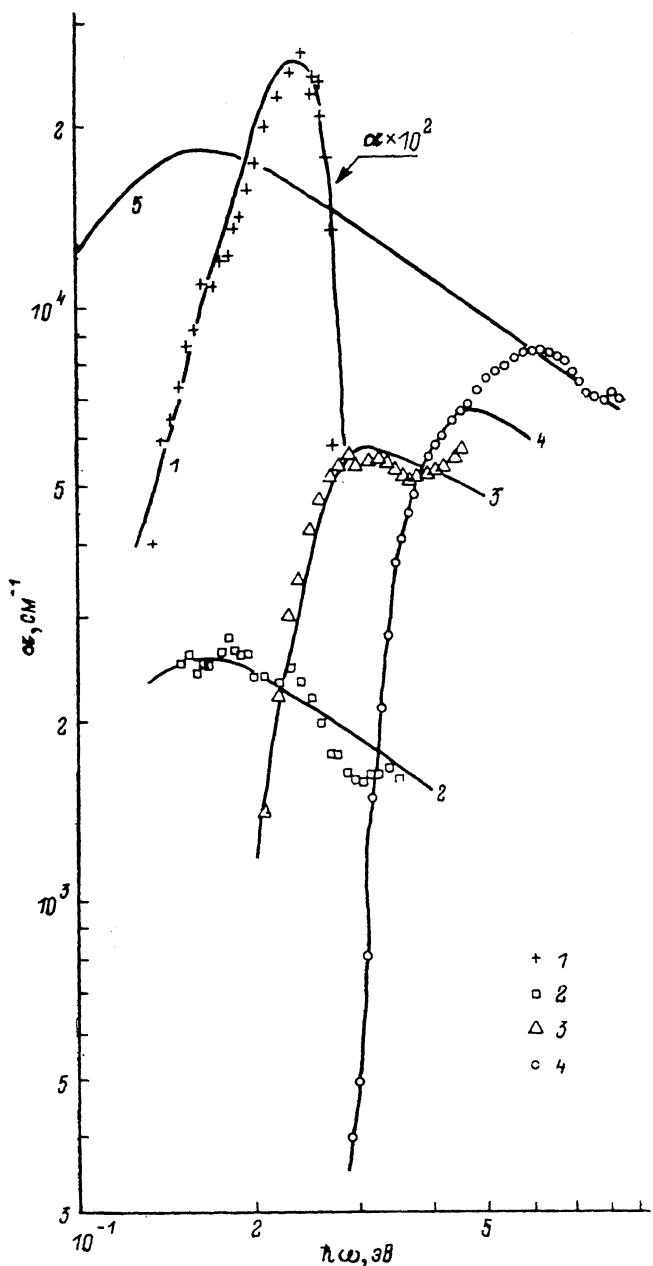


Рис. 2. Спектральные зависимости примесного поглощения в $\text{PbSe}\langle\text{In}, \text{Cl}\rangle$.

1-4 соответствуют обозначениям образцов на рис. 1; точки — эксперимент; линии — расчет: 1 — по формуле (1) работы [3] при $E_F = 0.065 \text{ эВ}$, $E_0^0 \rightarrow 1 = 0.29 \text{ эВ}$; 2-5 — по формуле (1) при E_F , эВ (E_0^* , эВ): 2 — (0.22) (0.11), 3 — 0.325 (0.08), 4 — 0.39 (0.02), 5 — 0.39 (0.28).

Полученный результат однозначно свидетельствует в пользу модели, предполагающей, что перезарядка примесных центров в $\text{PbSe}\langle\text{In}\rangle$ при введении дополнительного донора сопровождается существенным понижением их энергии.

Авторы признательны Б. А. Волкову за интерес к работе.

Список литературы

- [1] Кайданов В. И., Равич Ю. И. // УФН. 1985. Т. 145. В. 1. С. 51—86.
- [2] Кайданов В. И., Мельник Р. Б., Германас Н. В. // ФТП. 1972. Т. 6. В. 4. С. 726—728.
- [3] Беспалова Н. С., Вейс А. И., Прокофьева Л. В., Майлина Х. Р. // ФТП. 1987. Т. 21. В. 11. С. 2091—2094.
- [4] Прокофьева Л. В., Гуриева Е. А., Жумаксанов Ш. М., Константинов П. П., Майлина Х. Р., Равич Ю. И., Стильбанс Г. С. // ФТП. 1987. Т. 21. В. 10. С. 1778—1782.
- [5] Драбкин И. А., Мойкес Б. Я. / ФТП. 1981. Т. 15. В. 4. С. 625—648.
- [6] Волков Б. А., Тутушев В. В. / Письма ЖЭТФ. 1987. Т. 46. В. 5. С. 193—196.
- [7] Равич Ю. И., Ефимова Б. А., Смирнов И. А. Методы исследования полупроводников в применении к халькогенидам свинца PbTe, PbSe, PbS. М., 1968. 383 с.

Ленинградский политехнический
институт им. М. И. Калинина

Получена 13.01.1989
Принята к печати 7.03.1989